無電解ニッケルめっきによる異方性導電微粒子の作製

望月 勇*, 伊澤和彦**, 渡辺城司*, 本間英夫**

Preparation of Anisotropic Conductive Particles by Electroless Nickel Plating

Isamu MOCHIZUKI*, Kazuhiko IZAWA**, Jyoji WATANABE* and Hideo HONMA**

Demand for mechanical solderless chip connection methods using anisotropic conductive particles has increased in the field of electronic devises. In this study, the preparation of conductive resin particles (5 to $10 \,\mu\text{m}$ in diameter) by electroless nickel plating and the surface morphology of nickel film were investigated. Since the surface area of particles are much larger than in a bulk substrate, a batch-type electroless plating bath is unstable. Therefore, we applied the continuous dropping method to improve the stability of the Electroless nickel plating. The surface morphology of the deposited nickel was greatly influenced by the complexing agent used, the bath temperatrue and solution pH. Uniform deposits on the particles were obtained at pH 5 by using ammonium acetate as the complexing agent. In contrast, extraneous deposits were recognized at pH 5 when using sodium tartrate as the complexing agent and in baths at pH 6. This extraneous deposition could be decreased by lowering the bath temperature.

Key Words : Electroless Nickel Plating, Continuous Dropping Method, Anisotropic Conductive Particles

1. 緒 言

はんだは接続のみならずリペアも容易であることから, 電子部品の実装技術として幅広く用いられている。しか しガラス基板上ではんだを使用すると,熱膨張係数の差 により基板にクラックが発生することや,ファインパター ン上の接続ではソルダブリッジによるショートの発生 原因となるなどの問題点がある。また実装に伴うPbや VOCの規制などの環境問題が浮上してきており,ソル ダリング接続の限界が問われ始めている。従って,鉛を 使わずにこれらの規制に対応するための接続方法,つま り次世代のマイクロ接続の主流として,各種ソルダレス 接続法の検討が行われている。

異方性導電膜による接合法は、ソルダレス接続法の中 で比較的安価でリペアも容易であることから、現在,携 帯電話などを初めとして多くの電子部品の実装法として 使用されている。この異方性導電膜による電極の相互接 続図を図1に示す。導電膜中に分散している導電微粒子 には金属粒子や金属被覆したカーボン粒子、アルミナ粒 子、樹脂粒子などが用いられている^{1)~()}。この中で無 電解めっきを適用することにより作製した導電微粒子は、 高分子系の樹脂微粒子上に金属を成膜しているために、

* 関東学院大学 大学院 (〒236 神奈川県横浜市金沢区六浦町 4834)

Graduate School, Kanto Gakuin Univ. (4834, Mutsuuracho, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236)

- **関東学院大学 工学部 (〒236 神奈川県横浜市金沢区六浦町 4834)
 - Fac. of Eng., Kanto Gakuin Univ. (4834, Mutsuuracho, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236)



Fig. 1 The model of electrode connecting method from anisotropic conductive particles.

熱膨張や圧着接合時の寸法変化に対して弾性変形範囲が 広く,接続部材として適している。

本報では素材としてスチレン系の樹脂微粒子を用い, 無電解ニッケルめっきによりニッケル導電膜を形成させ, その成膜状態や皮膜特性,また圧縮変形時の皮膜の柔軟 性について評価した。

2. 実験方法

2.1 前処理

素材として、粒径が 5~10 μmのポリスチレン系樹脂 微粒子(密度:1.02g/cm³) 10g を使用した。この樹脂 微粒子をノニオン系界面活性剤であるポリエチレング リコール(分子量:1000)を100ppm添加した溶液で親 水化し、次いでスズーパラジウム二段法(SnCl₂ 0.1g /L, PdCl₂ 0.05g/L)による触媒付与後、還元剤溶液 (DMAB 0.005M)による活性化促進処理を行った。



Fig. 2 Experimental apparatus for nickel deposition.

2.2 めっき浴組成および浴条件

微粒子に無電解めっきを行う場合, 微粒子1g 当たり の比表面積が16m²と異常に大きいため、従来用いられ ているバッチ法では初期のめっき反応が非常に速く、めっ き直後に浴分解を引き起こしてしまう。まためっき反応 の制御が困難なため、粗雑で密着性の悪い皮膜になりや すい。そこで本研究では滴下法 6). 6) により樹脂微粒子 上にニッケルを成膜した。めっき装置図を図2に、浴組 成および操作条件を表1に示す。この滴下法は、あらか じめ金属塩溶液と還元剤溶液を別々に調製しておき、微 粒子の分散液中に調製溶液を連続的に滴下することで無 電解めっきを行う方法である。金属塩と還元剤の滴下速 度を制御することでめっき反応を緩慢に進行させ、浴分 解を抑制することができる。また滴下量を定量ポンプに より容易に調節できるため、析出させる金属の膜厚調節 を正確に行うことができ、コスト面でもバッチ法に比べ て安価である。

2.3 めっき浴の pH, 錯化剤, 温度の影響

基本浴組成でめっきを行った場合,めっき浴の pH が 6以上では水酸化ニッケルが生じ易く, また pH4以下 ではめっき反応が生起せずニッケルの成膜が困難であっ た。これにより、めっき浴のpHは4~6の弱酸性領域 で使用した。浴温は25~70℃, 錯化剤にはグリシン, 酒石酸ナトリウム, 酢酸アンモニウムを使用し, 析出し たニッケルの表面観察を行った。ニッケルめっき後の導 電微粒子は、表面形態を走査型電子顕微鏡(SEM)に より観察し、めっき膜厚はプラズマ発光分光分析 (ICP) によるニッケル定量値から算出した。

2.4 ニッケルの結晶構造およびリン含有率の測定

比表面積が異常に大きく、また反応性が強い微粒子上 に析出した無電解ニッケルめっき皮膜の結晶構造を, X 線回折装置(XRD)により解析した。またニッケル皮 膜中のリン含有率を電子線プローブマイクロアナライザー (EPMA) により測定した。

Table. 1 Electroless nickel bath composition and operating conditions

Dropping solution	
$A : NiSO_{\bullet} \cdot 6 H_{\bullet}O$	0.85M
Complexing agent	0.85M
B : NaH ₂ PO ₂ • 2 H ₂ O	2.0M
NaOH	1.0~2.0M
Dispersant solution	
NaH2PO2 • 2 H2O	0.2M
pH	4~6
Temp.	25~70℃
Dropping speed	3 ml/min.
Plating time	0.5∼1 h
Volum	100~280ml



Fig. 3 SEM photographs of resin particles with nickel metallization at pH 4 to 6.

2.5 皮膜形態と柔軟性

異方性導電微粒子は、相互接続で使用される際に電極 間で熱または紫外線により圧着されるため、微粒子自身 に柔軟性が必要となる。素材の樹脂には柔軟性があるた め、その上に成膜するニッケル皮膜に柔軟性が必要とさ れる。そこで皮膜形態の異なるニッケル皮膜について、 粉体用微小圧縮試験器。)により皮膜の柔軟性を測定し た。この圧縮試験器は導電微粒子に負荷をかけ、皮膜が 破断したときの負荷量を測定する装置である。

3. 実験結果および考察

3.1 めっき浴組成の検討

3. 1. 1 均一析出性におよぼす錯化剤, pHの影響 錯化剤としてグリシン、酒石酸ナトリウム、酢酸アン モニウムを用いためっき浴を使用し、pHを4~6の範 囲で変化させニッケルめっきを行った。また浴温は70 ℃とし、めっき膜厚はめっき時間を変化させて0.2µm に統一した。めっき後の微粒子の SEM像を図3に示す。 pH6のめっき浴では、ニッケルの皮膜形態はいずれの





Fig. 4 SEM photographs of resin particles with nickel metallization at 25 to 70°C.

(A) Sodium tartrate bath, (B) Glycine bath,

錯化剤を用いてもニッケルの初期析出が急激に起こるため、こぶ状析出となった"。pH5の場合、こぶ状析出はかなり抑制され、粒子の凝集に基づくディンプル状のニッケル未析出部分が確認された。このようなディンプル状析出は、素材粒子が5~10µmと非常に微小であるため、めっき中に凝集した状態でニッケルめっきされたことが原因であると考えられる。またpH5の酢酸アンモニウム浴からは、均一性に優れたニッケル皮膜が得られた。同様にpH4のめっき浴では、いずれの錯化剤を用いてもディンプル析出が抑制され、均一析出性に優れた皮膜が得られた。またニッケルめっき後の微粒子の凝集もほとんどなく、良好に分散していることが確認された。

3.1.2 浴温の影響

以上の実験から、浴温70℃のめっき浴で得られるこ ぶ状,ディンプル状,および均一の皮膜形態を形成する 代表的なめっき条件を選定し、さらに浴温の影響につい て検討を進めた。その結果を図4に示す。pH6の酒石 酸ナトリウム浴は、70℃のめっき浴で著しい微粒子の凝 集とこぶ状析出が認められるが、浴温が50℃、25℃と 低下するに従いこぶ状析出が抑制されることが確認され た。pH5のグリシン浴からは、70℃のめっき浴で得ら れたディンプル状析出は、浴温を50℃に低下させるこ とにより均一性に優れた皮膜となったが、さらに25℃ まで低下させると粗雑な皮膜に変化した。一方, pH4 の酒石酸ナトリウム浴からは、浴温70℃~50℃まで均 一性に優れたニッケル皮膜が得られたが、浴温を25℃ まで低下させるとニッケル皮膜のはく離が確認された。 すなわち浴温を25℃まで低下させると次亜リン酸ナト リウムの還元力が弱くなり、微粒子表面の活性部位のみ に優先的に析出反応が進行するため、粗雑な皮膜や皮膜



Fig. 5 X-ray diffractgrams of various phosphorus contents of Ni-P alloy films.

のはく離の原因になったと考えられる。

3.2 X線回折による皮膜の結晶構造の解析

滴下法によるめっき反応時のめっき浴中のニッケルイ オン濃度は、ニッケルイオンとして50g/Lの濃厚な金 属塩溶液を滴下しているにもかかわらず、約200~500 ppmに減少し、ほとんどの金属塩が滴下と同時に激し く消耗していることが確認されている")。このような 激しい反応系で得られた皮膜が、一般の無電解ニッケル めっきで得られた皮膜と同様な結晶特性を示すかどうか について検討した。まずニッケル皮膜中のリン含有率を EPMAを用いて測定し、その結果からリン含有率の異 なる5種類の皮膜の結晶構造をX線回折により解析し た。結果を図5に示す。pH6のグリシン浴で得られた ニッケル皮膜中のリン含有率は4.9wt%であり、Ni (111), (200)、(220)、(311)面に相当する回折ピークが確認さ れた。これに対して pH6の酒石酸ナトリウム浴から は、リン含有率が6.1wt%、また酢酸アンモニウム浴か らは8.1wt%の中リン皮膜が得られ、Ni (111) 面の回折 ピークは低下し、他の指数面は完全にブロードになった。 さらに酢酸アンモニウム浴の pHが5 で9.7wt%, pH4 では12.9wt%となり、Ni (111) 面の回折ピークも完全 にブロードとなった。また均一性に優れた皮膜は、すべ て皮膜中のリン含有率が10wt%以上であることが確認 された。以上の結果から、比表面積の大きい微粒子上で 得られたニッケルーリン皮膜の結晶構造が一般のめっき 皮膜と同じ結晶性を示すことが確認された。

⁽C) Ammonium acetate bath



Fig. 6 Relationship between load and deformation of particle on anisotropic conductive particles. (O: Crack point)

3.3 皮膜の柔軟性

LCDとTCP、PCBとTCP、LCDとICなどの接続 に用いられる異方性導電微粒子は、電極間で熱または紫 外線圧着されるために変形し、皮膜に応力が加わる。そ の際に皮膜にクラックが発生すると接続信頼性の低下の 原因となるため、樹脂上に成膜する金属膜に柔軟性が必 要になる。そこで pH5 で得られた中リン皮膜(7~10 wt%)で皮膜形態の異なる導電微粒子を用い、粉体用 微小圧縮試験器。こより皮膜の柔軟性を測定した。結 果を図6に示す。測定には均一皮膜、こぶ状皮膜、ディ ンプル状皮膜の3種類の導電微粒子を使用した。針状の プローブで微粒子を徐々に圧縮したところ、ディンプル の多い皮膜は0.20gf, こぶ状皮膜では0.45gf 以上, ま た均一な皮膜では0.55gf以上の荷重で皮膜にクラック を生じた。こぶ状皮膜に関しては他の皮膜とは異なり、 クラックが一定荷重で急激に生じている。このこぶ状皮 膜は反応速度の速いめっき浴から得られる傾向が高い。 従って析出皮膜中への水素の取り込みも皮膜の脆弱さに 関係していると考えられる。均一な皮膜は、こぶ状皮膜 やディンプル状皮膜と比較してより大きな負荷をかける ことができ、この3種類の皮膜中では最も弾性変系範囲 が広いことが確認された。

以上の検討から、pH4,70℃の酢酸アンモニウム浴 から得られた最も均一な皮膜を下地として、この上に置 換金めっきにより金を成膜したところ、図7に示すよう に均一な金属膜をもつ良好な導電微粒子(体積固有抵抗 値:1.4mΩ.cm)の作製が可能であることが確認された。

4.結論

滴下法により,粒径が5~10μmのスチレン系樹脂微 粒子上に無電解ニッケルめっきを行った結果,以下の結 論を得た。



Fig. 7 SEM photographs of nickel and gold deposition on optimum condition.

 めっき浴の pHを4 に調整することにより、均一で ち密なニッケル連続膜の形成が可能であった。

(2)使用する錯化剤によりニッケルの析出形態は異なり、 錯化剤として酢酸アンモニウムを用いためっき浴から均 一なニッケル皮膜が得られた。

(3) ニッケルのこぶ状析出は、浴温を50℃で操作することにより抑制することが可能であった。

(4) pH4, 浴温70℃のめっき浴は,いずれの錯化剤を用いても均一な皮膜を得ることが可能であった。しかし, 浴温を25℃まで低下させると皮膜のはく離が確認された。

(5) 微粒子は反応面積が異常に大きく、低濃度で連続的に激しく反応するが、皮膜の結晶構造は一般のめっき皮膜と同じであった。また錯化剤により多少の差はあるが、10wt%以上のリンを含むニッケル皮膜は均一性に優れていることが確認された。

(6) 析出したニッケルが均一,ディンプル状,またはこ ぶ状の3種類の導電微粒子について皮膜の柔軟性を測定 した結果,均一なニッケル皮膜をもつ導電微粒子は,負 荷荷重が最も高い0.55gfまで皮膜にクラックが発生す ることなく,微粒子が緩やかに変位していることから, 弾性変形範囲が最も広いことが確認された。

(Received October 29, 1996; Accepted February 17, 1997)

文 献

- 1) 竹島鋭機, 坂倉 昭; 表面技術, 41, 284 (1990)
- 2) 竹島鋭機;表面技術, 41, 145 (1990)
- 3) 竹島鋭機, 高津 清; 表面技術, 41, 151 (1990)
- 4)竹島鋭機,藤井孝浩,高津 清,坂倉 昭;表面技術,41, 278 (1990)
- 5) 川上 浩, 竹下淳一; 特公平6-96771 (1994)
- 6) C. D. Lacovangelo; Plating & Surface Finishing, 77, Sep. (1995)
- 7)本間英夫,萩原 謙,佐藤直樹;回路実装,10,148(1995)
 8)竹下淳一;表面実装,47,896(1996)